

Изобретение относится к способам внедрения "гостевого" компонента в твердые тела со слоистой кристаллической структурой. Предложенный способ заключается в лазерном излучении под углом $90^\circ \pm 10^\circ$ к плоскости пленки "гостевого" компонента, нанесенной на одну из граней образца, которая параллельна кристаллографической оси С. При этом количество внедренного интеркалянта (примесей) регулируется толщиной нанесенной пленки, величиной плотности энергии излучения в импульсе и количеством лазерных импульсов.